

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753
 ルネサス エレクトロニクス株式会社
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A078A/J	Rev.	第1版
題名	RX111 グループ ROMに関する電気的特性の追加		情報分類	技術情報	
適用製品	RX111 グループ	対象ロット等	関連資料	RX111 グループ ユーザーズ マニュアルハードウェア編 Rev.1.00 (R01UH0365JJ0100)	
		全ロット			

RX111 グループ ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev.1.00のROM特性において、記載内容の追加がありますので以下のとおり連絡いたします。

•Page 1193 of 1206

表36.47、表36.48に以下のとおり赤字の部分の特性を追加いたします。

表36.47 ROM (コード格納用フラッシュメモリ) 特性(2) 高速動作モード・中速動作モード

条件: VCC = AVCC0 = 2.7 ~ 3.6 V, VSS = AVSS0 = VREFL0 = 0 V

プログラム/イレーズ時の動作温度範囲: T_a = -40 ~ +105°C

項目	記号	FCLK = 1 MHz			FCLK = 32 MHz			単位	
		min	typ	max	min	typ	max		
プログラム時間	4バイト	t _{P4}	—	1650	4910	—	100	761	μs
イレーズ時間	1Kバイト	t _{E1K}	—	9.77	329	—	5.53	258	ms
ブランクチェック時間	4バイト	t _{BC4}	—	—	5000	—	—	316	μs
	1Kバイト	t _{BC1K}	—	—	1280	—	—	80.7	ms
イレーズサスペンド時間	t _{SED}	—	—	21.6	—	—	12.8	μs	
スタートアップ領域入れ替え設定時間	t _{SAS}	—	14.3	545	—	6.22	432	ms	
アクセスウィンドウ設定時間	t _{AWS}	—	14.3	545	—	6.22	432	ms	

表36.48 ROM (コード格納用フラッシュメモリ) 特性(3) 中速動作モード

条件: VCC = AVCC0 = 1.8 ~ 3.6 V, VSS = AVSS0 = VREFL0 = 0 V

プログラム/イレーズ時の動作温度範囲: T_a = -40 ~ +105°C

項目	記号	FCLK = 1 MHz			FCLK = 8 MHz			単位	
		min	typ	max	min	typ	max		
プログラム時間	4バイト	t _{P4}	—	1690	5380	—	290	1680	μs
イレーズ時間	1Kバイト	t _{E1K}	—	9.84	331	—	6.04	275	ms
ブランクチェック時間	4バイト	t _{BC4}	—	—	4980	—	—	973	μs
	1Kバイト	t _{BC1K}	—	—	1270	—	—	250	ms
イレーズサスペンド時間	t _{SED}	—	—	33.6	—	—	25.6	μs	
スタートアップ領域入れ替え設定時間	t _{SAS}	—	14.9	551	—	7.82	446	ms	
アクセスウィンドウ設定時間	t _{AWS}	—	14.9	551	—	7.82	446	ms	

以上